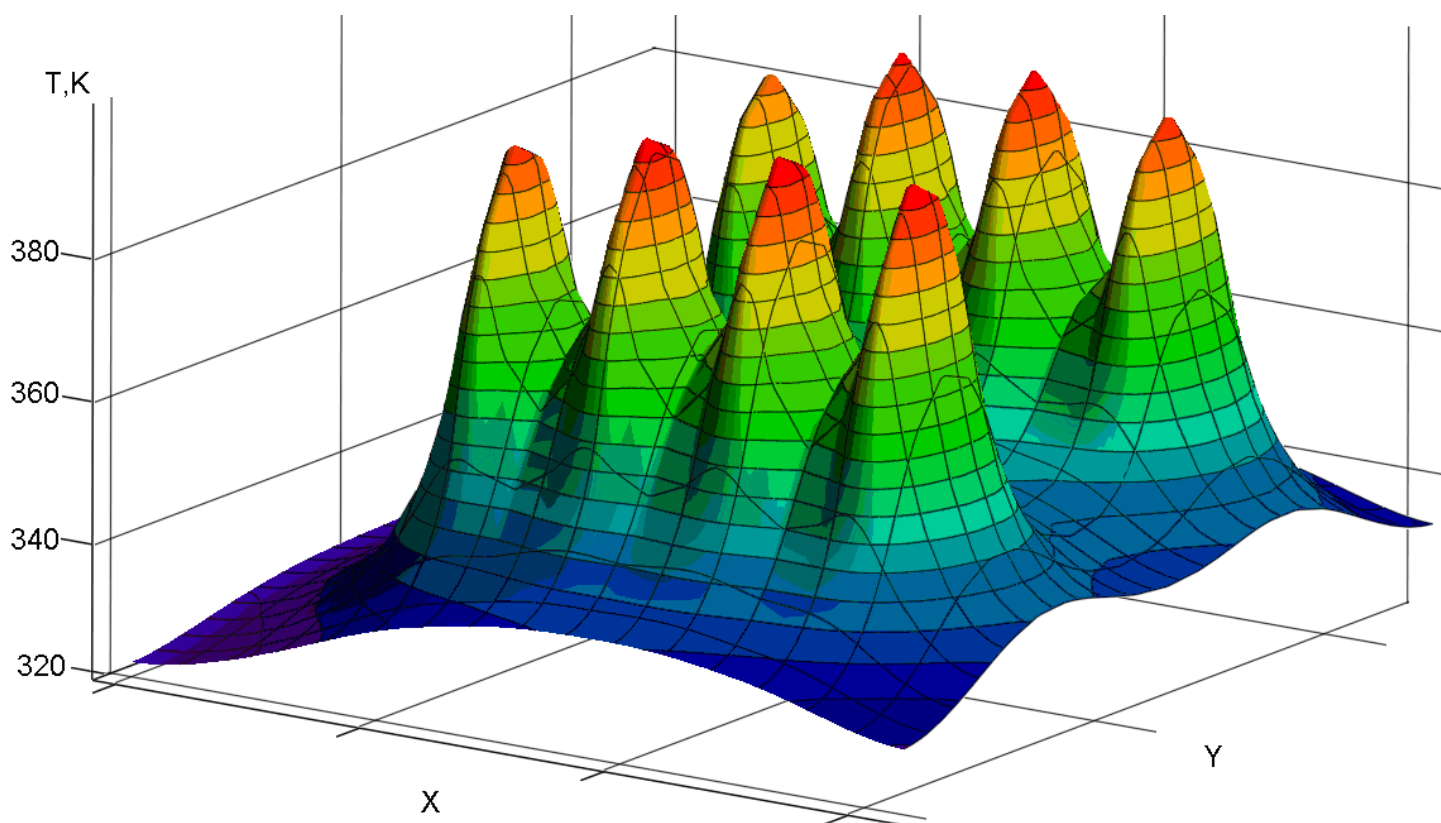


# I Международная конференция «Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов»



Конференция будет проводиться с 21 по 23 октября 2019 г. в Москве на базе Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН.

## Тематика конференции:

Современные проблемы создания исследовательской инфраструктуры для синтеза новых материалов с заданными свойствами, включая применение новых методов и средств анализа больших данных;

проблемы развития материаловедения наноразмерных электронных гетероструктур;

Математическое моделирование в структурном материаловедении (многоуровневые, многомасштабные модели, имитационные модели и т.д.).

Моделирование размерных, радиационных, поверхностных и других дефектов в полупроводниковой наноэлектронике;

Моделирование работы многоуровневых элементов памяти для компьютеров следующего поколения;

Моделирование структур и свойств композиционных материалов с нанокристаллами, нанокластерами, наноаморфными включениями и т.д.

## Место проведения конференции

Конференция будет проводиться в Вычислительном центре Федерального

исследовательского центра "Информатика и управление" РАН, по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.40.

## **Представление материалов для участия**

Тезисы докладов должны быть присланы не позднее 21 июня 2019 г. с названием и авторами предполагаемого доклада и заполненной заявкой на участие ([matmodel2013@gmail.com](mailto:matmodel2013@gmail.com)).

Тезисы докладов принимаются в формате Microsoft Word. Объем - до трёх полных страниц формата А4. Правила оформления: поля со всех сторон 25 мм, шрифт Times New Roman, кегль 12pt, межстрочный интервал полуторный. Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation или MathType.

Тексты статей для публикаций в журналах из списка ВАК - Известия вузов. Материалы электронной техники (специальный выпуск), Электроника НТБ, Наноиндустрия, Фотоника за 2019 г. необходимо направить на рецензирование по электронному адресу [matmodel2013@gmail.com](mailto:matmodel2013@gmail.com) до 15 июля 2019 г.

Отдельные из статей будут опубликованы в журналах Russian Microelectronics (WoS) и Phys.st.sol. (B) (WoS, Scopus).

Для участия в Конференции в качестве слушателя (без доклада) необходимо до 1 октября 2019 г. направить по электронному адресу [matmodel2013@gmail.com](mailto:matmodel2013@gmail.com) заполненную [заявку на участие](#).